

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/032930 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) **C09G 1/02** (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) **C09K 3/14** (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/032453

(22) 国際出願日: 2022年8月29日(29.08.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
PCT/JP2021/031894 2021年8月31日(31.08.2021) JP
PCT/JP2021/031892 2021年8月31日(31.08.2021) JP
特願 2022-088818 2022年5月31日(31.05.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 荒田 彰吾 (**ARATA Shogo**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 市毛 康裕 (**ICHIGE Yasuhiro**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (**HASEGAWA Yoshiki et al.**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** POLISHING LIQUID, POLISHING METHOD, COMPONENT MANUFACTURING METHOD, AND SEMICONDUCTOR COMPONENT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨液、研磨方法、部品の製造方法、及び、半導体部品の製造方法

(57) **Abstract:** This polishing liquid contains cerium oxide abrasive grains and ammonium salt, and has a pH of at least 9.00. This polishing method uses the polishing liquid to polish a member to be polished that contains copper. This component manufacturing method enables a component to be obtained by using the member to be polished which has been polished using the polishing method. This semiconductor component manufacturing method enables a semiconductor component to be obtained by using the member to be polished which has been polished using the polishing method.

(57) 要約: セリウム酸化物を含む砥粒と、アンモニウム塩と、を含有し、pHが9.00以上である、研磨液。前記研磨液を用いて、銅を含有する被研磨部材を研磨する、研磨方法。前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。



WO 2023/032930 A1